

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

日時 6月21日(金) 11:00~17:05

会場 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリーベンチャーホール3F (名古屋市千種区不老町 B2-4. <http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html>)

議題 MOS デバイス・メモリ高性能化—材料・プロセス技術

1. NO 窒化処理を施した SiO<sub>2</sub>/SiC 界面近傍の窒素分布評価 ○細井卓治・Kidist Moges (阪大)・染谷 満 (産総研)・志村考功 (阪大)・原田信介 (産総研)・渡部平司 (阪大)
2. Ultra-low resistance contact for n-type Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> with in-situ Sb heavily doping and nickel stanogermanide formation  
○Jihee Jeon・Akihiro Suzuki・Shigehisa Shibayama・Shigeaki Zaima・Osamu Nakatsuka (Nagoya Univ.)
3. 熱処理による Al/Ge(111) 上の極薄 Ge 層形成  
○小林征登・大田晃生・黒澤昌志・洗平昌晃・田岡紀之・池田弥央・牧原克典・宮崎誠一 (名大)
4. イオン注入法による IV 族半導体混晶薄膜の歪緩和促進機構について  
○祖父江秀隆・福田雅大・柴山茂久・中塚 理 (名大)

午後 (13:30~)

5. [依頼講演] デバイスから見た 2D/3D ナノ計測の必要性 白田宏治 (東芝メモリ)
6. [依頼講演] 超音波原子間力顕微鏡によるナノ領域弾性特性評価  
○辻 俊宏 (東北大)・山中一司 (ポールウェーブ)
7. [依頼講演] 光電子ホログラフィー法によるシリコン中に高濃度ドーブされた活性及び不活性な不純物原子の三次元原子配列構造の観測 ○筒井一生 (東工大)・松下智裕 (高輝度光科学研究センター)・名取鼓太郎・小川達博 (東工大)・室 隆桂之 (高輝度光科学研究センター)・森川良忠 (阪大)・星井拓也・角嶋邦之・若林 整 (東工大)・林 好一 (名工大)・松井文彦 (分子科学研)・木下豊彦 (高輝度光科学研究センター)
8. [依頼講演] X 線によるナノデバイス及び格子欠陥の三次元観測 ○表 和彦・伊藤義泰 (リガク)
9. 超急峻スイッチングを可能にする VO<sub>2</sub> モットトランジスタの特殊な動作モード  
○矢嶋赳彬・佐俣勇佑・西村知紀・鳥海 明 (東大)
10. 超格子 GeTe/Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> メモリの第一原理計算による構造変化シミュレーション  
○小川湧太郎・野原弘晶・白川裕規・洗平昌晃・白石賢二 (名大)
11. ホウ素導入を行った ALD-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GaN-MOS キャパシタにおける界面特性評価  
○出来真斗・奥出 真・安藤悠人・渡邊浩崇・久志本真希・田中敦之・新田州吾・本田善央・天野 浩 (名大)
12. HfSiO<sub>x</sub>/GaN (0001) の化学構造及び電子状態分析  
○大田晃生・牧原克典 (名大)・生田目俊秀 (NIMS)・塩崎宏司・宮崎誠一 (名大)

◆応用物理学会；シリコンテクノロジー分科会共催

【問合先】

諸岡 哲 (東芝メモリ)

TEL [059] 390-7451, FAX [059] 361-2739

E-mail: tetsu.morooka@toshiba.co.jp